

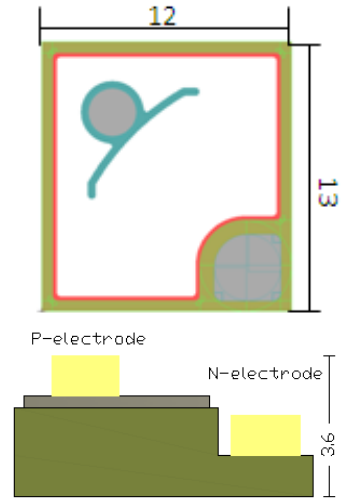
紫光 LED 芯片规格说明书 (产品规格型号: ZW-1312U)

◆ 产品特点

- 高亮度、长寿命
- 芯片百分之百测试分选
- 波长和光强良好的一致性
- 高可靠性, 低漏电

◆ 物理参数

结构	InGaN/GaN structure on sapphire EPI wafer
P、N 电极	Au
芯片尺寸	13mil×12mil(325±5μm×300±5μm)
芯片厚度	4.8mil(120±5μm)
焊盘尺寸	3.0mil(75±5μm)



单位: mil

◆ 光电特性 (360nm-370nm,  $I_F=20\text{mA}$ ,  $T_c=22^\circ\text{C}$ )

性能参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值
正向电压 (V)	$V_F$	$I_F=20\text{mA}$	$V_1$	3.0	3.2	3.4
			$V_2$	3.4	3.6	3.8
			$V_3$	3.8	4.0	4.2
反向电流 ( $\mu\text{A}$ )	$I_R$	$V_R=5\text{V}$		0	$\leq 0.1$	1
波长范围 (nm)	$\lambda_p$	$I_F=20\text{mA}$		360	365	370
最大电 (mA)	$I_{MAX}$	DC		30		

◆ 光功率等级 (360nm-370nm):

等级	$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$
IV 范围 (mw)	0.1~0.5	0.5~1	1~2	2~3	3~4	4~5
等级	$I_6$	$I_7$	$I_8$	$I_9$	$I_{10}$	
IV 范围 (mw)	5~6	6~7	7~8	8~9	...	

◆ 其它说明

- 封装工艺的温度不得超过  $220^\circ\text{C}$ 。
- 该产品是一级防静电元件, 产品运输和封装过程中应有静电保护。
- 亮度值是基于西安中为裸芯测试台。
- 可根据客户要求定做特殊规格的芯片。